

2SA1221, 1222

PNPエピタキシャル形シリコントランジスタ

低周波電力増幅用

PNP Silicon Epitaxial Transistor
Audio Frequency Power Amplifier

特長/FEATURES

- TVの垂直偏向出力、音声出力および各種電源など高耐圧大電流用途に最適です。
- 2SC2958, 2SC2959とコンプリメンタリで使用できます。

$V_{CEO}=140\text{ V}\cdots 2SA1221/2SC2958$

$V_{CEO}=160\text{ V}\cdots 2SA1222/2SC2959$

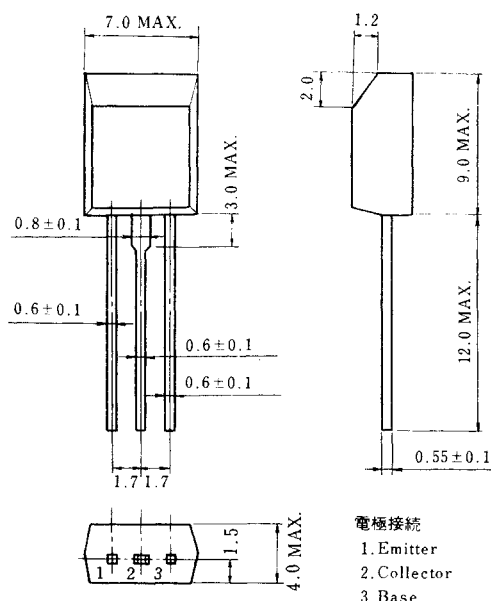
絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-160	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-140/-160	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	-500	mA
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)*}$	-1.0	A
全 損 失	P_T	1.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

* $PW \leq 10\text{ ms}$, Duty Cycle $\leq 50\%$

外形図/PACKAGE DIMENSIONS

(Unit: mm)



電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

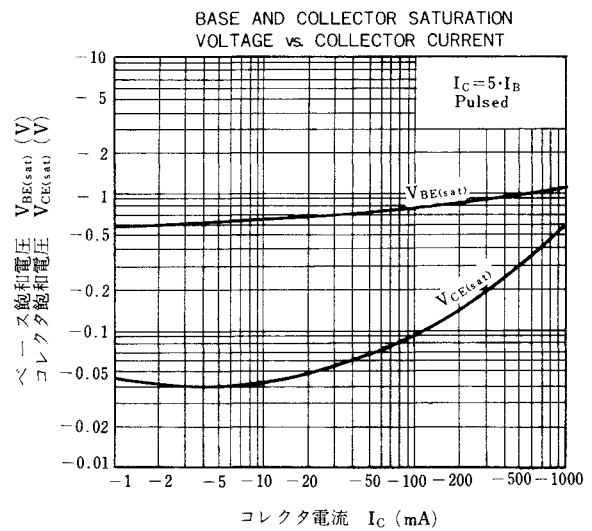
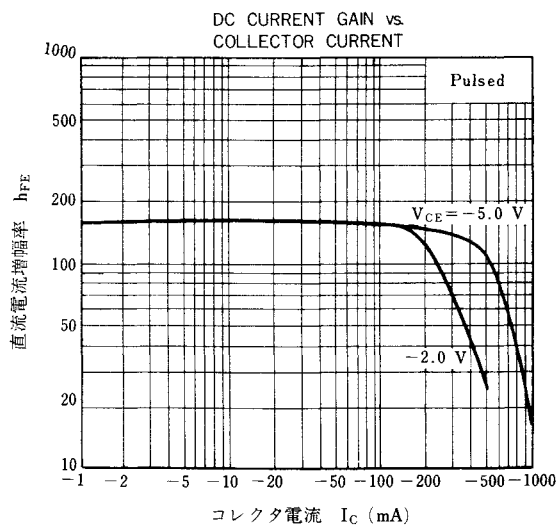
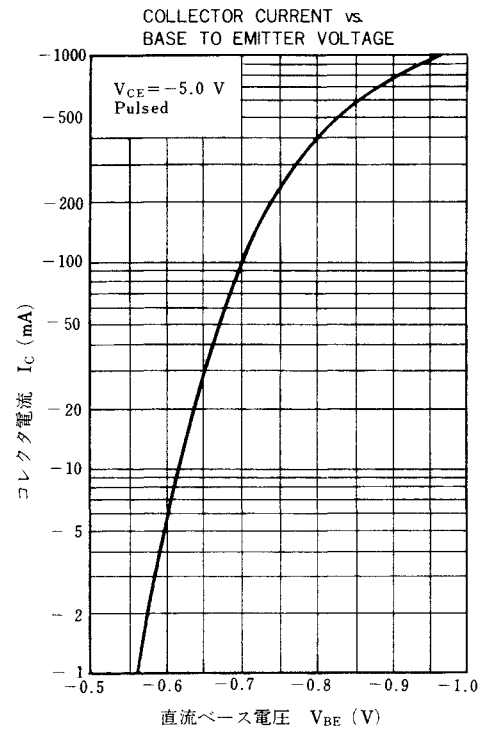
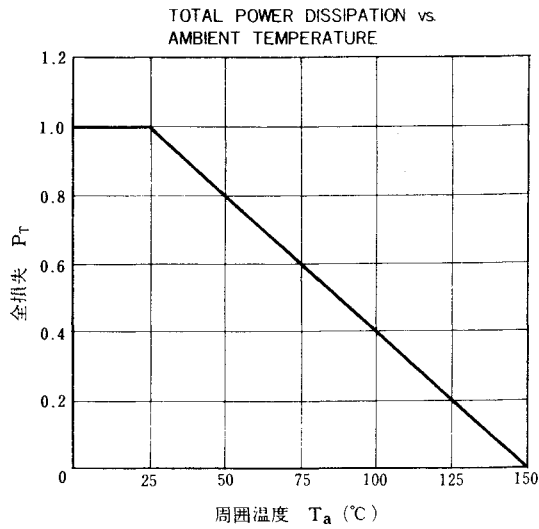
項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-100\text{ V}$, $I_E=0$			-200	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5.0\text{ V}$, $I_C=0$			-200	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE}^{**}	$V_{CE}=-2.0\text{ V}$, $I_C=-100\text{ mA}$	100	150	400	
直 流 ベース電圧	V_{BE}^{**}	$V_{CE}=-5.0\text{ V}$, $I_C=-20\text{ mA}$	-0.6	-0.64	-0.7	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}^{**}$	$I_C=-1.0\text{ A}$, $I_B=-0.2\text{ A}$		-0.6	-0.9	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}^{**}$	$I_C=-1.0\text{ A}$, $I_B=-0.2\text{ A}$		-1.1	-1.3	V
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{ V}$, $I_E=0$, $f=1.0\text{ MHz}$		24	40	pF
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=-10\text{ V}$, $I_E=20\text{ mA}$	30	45		MHz

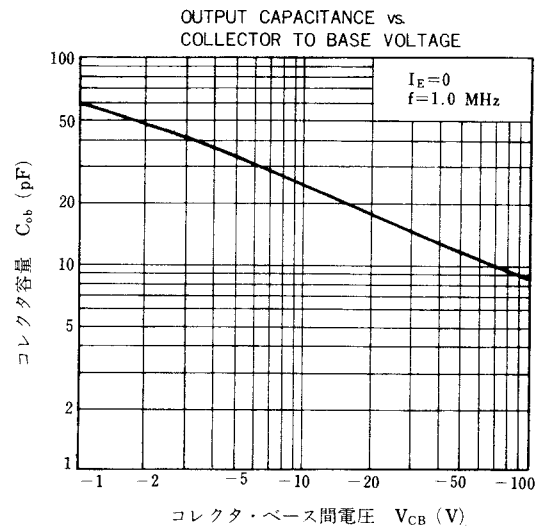
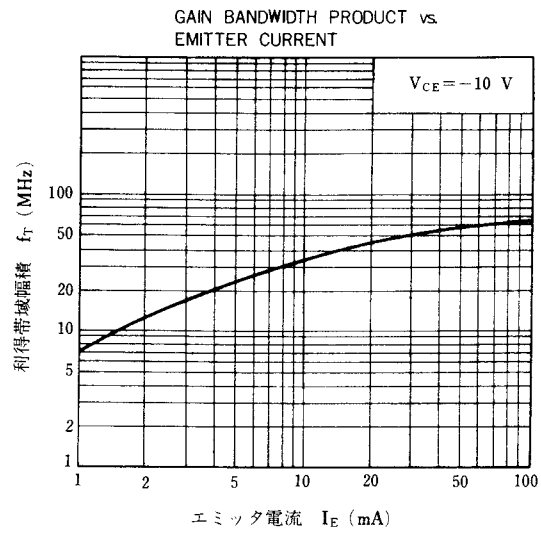
**ハルス測定 $PW \leq 350\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$, Pulsed

h_{FE} 規格区分

捺 印	M	L	K
h_{FE}	100~200	160~320	200~400

特線曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)





[illegible][illegible]